



ON4402H-3G: Mosfet RF Gain 3



Descripción

Nombre: MOSFET RF GAIN 3 **Referencia:** ON4402H-3G

- **Voltajes Máx:**
 - **Vgate-source:**20V.
 - **Vdrain-source:**110V
- **Corriente drain:** 9A
- **Ganancia:** 3

Marca: PHILIPS **Empaque:** .28 4L STUD **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [ON4402H-3G](#)

Información del producto

Descripción: MOSFET RF GAIN 3 PHILLIPS Referencia: ON4402H-3G El transistor **ON4402H** es un componente electrónico semiconductor de tipo NPN, diseñado específicamente para aplicaciones de radiofrecuencia (RF). Su estructura interna y características lo hacen ideal para amplificar señales de alta frecuencia con baja distorsión y alta eficiencia.

Precio: \$641.172 IVA INCLUIDO

SKU: 9-11-54

Categorías: [RF TRANSISTORES Y MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

Etiquetas: [0090011000054](#), [9-11-54](#), [datasheet](#), [MOSFET RF GAIN 3](#), [ON4402H-3G](#), [PHILIPS](#), [SEMICONDUCTORES](#), [SMD](#)

